

Сведения о ведущей организации

1.	Полное наименование организации	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
2.	Сокращенное наименование организации	СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
3.	Ведомственная принадлежность	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
4.	Место нахождения	г.Санкт-Петербург
5.	Почтовый адрес организации с указанием индекса	ул. Профессора Попова, д.5, Санкт-Петербург, 197376
6.	Телефон с указанием кода города	(812) 234-46-51
7.	Адрес электронной почты	info@etu.ru
8.	Адрес официального сайта в сети «Интернет»	https://etu.ru
9.	Руководитель организации	Шелудько Виктор Николаевич
10.	Уполномоченный	Лучинин Виктор Викторович
11.	Должность	Директор департамента науки
12.	Ученая степень	д.т.н.
13.	Ученое звание	профессор
14.	Список основных публикаций работников ведущей организации по тематике диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1. А.И. Михайлов, А.В. Афанасьев, В.А. Ильин, В.В. Лучинин, С.А. Решанов М. Krieger , A. Schöner , T. Sledziewski. «Ионная имплантация фосфора как метод пассивации состояний на границе раздела 4H-SiC и SiO₂, полученного термическим окислением в атмосфере сухого кислорода» //Физика и техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 12, С.1621 – 1625.</p> <p>2. Афанасьев А.В., Иванов Б.В., Ильин В.А., Кардо-Сысоев А.Ф., Лучинин В.В., Смирнов А.А., Шевченко С.А. Исследование процессов переключения карбидокремниевых дрейфовых диодов с резким восстановлением. Электроника</p>

и микроэлектроника СВЧ. 2015. Т. 2. № 1. С. 215-219.

3. Golubkov V.A., Ivanov A.S., Ilyin V.A., Luchinin V.V. and Bogdanov S.A.*, Chernov V.V.*, Vikharev A.L. Diamond dielectric thin film stabilizing effect on silicon carbide nanostructured field emission array 2015 International Workshop on Dielectric Thin Films for Future Electron Devices – Science and Technology, Proceedings (2015 г.)

4. A. V.Afanasyev, B. V. Ivanov, V. A. Ilyin, A. F. Kardo-Sysoev, V. V. Luchinin, S.A.Reshanov, A. Schoner, A.A.Smirnov. Temperature dependence of minority carrier lifetime in epitaxially grown p+-p- -n+ drift step recovery diodes. Material Science Forum, v.821-823 (2015), p.p.632-635.

5. Афанасьев А.В., Иванов Б.В., Ильин В.А., Кардо-Сысоев А.Ф., Лучинин В.В., Смирнов А.А., Шевченко С.А. Исследование процессов переключения карбидокремниевых дрейфовых диодов с резким восстановлением. Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2015. Т. 2. № 1. С. 215-219.

6. Golubkov V.A., Ivanov A.S., Ilyin V.A., Luchinin V.V. and Bogdanov S.A.*, Chernov V.V.*, Vikharev A.L. Diamond dielectric thin film stabilizing effect on silicon carbide nanostructured field emission array 2015 International Workshop on Dielectric Thin Films for Future Electron Devices – Science and Technology, Proceedings (2015 г.)

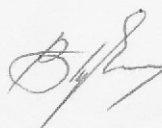
7. A.V. Afanasyev, V.A. Ilyin, V.V. Luchinin, S.A. Reshanov, A. Schöner, K.A. Sergushichev, A.A. Smirnov. Effect of Neutron Irradiation on Epitaxial 4H-SiC PiN UV-Photodiodes. Material Science Forum, Trans. Tech. Publications, Switzerland, v.897 (2017), p.p.614-617.

8. А. В. Афанасьев, Б. В. Иванов, В. А. Ильин, А. Ф. Кардо-Сысоев, В. В. Лучинин, А. А. Смирнов, С. А. Шевченко. Исследование процесса восстановления диодных лавинных обострителей на основе 4H-SiC при работе в

	<p>периодическом режиме // Электроника и микроэлектроника СВЧ, 2017, т.1, №1, с.270 - 274.</p> <p>9. Luchinin V., Afanasjev A., Ilyin V., Korlyakov A., Petrov A. Family of micro switches based on silicon carbide for extreme conditions and duty // Proceedings of the 2017 11th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, EMCCompo 2017, 7998089, С. 97-99.</p> <p>10. Афанасьев А., Вьюгинов В., Гладков Н., Зыбин А., Ильин В., Клевцов В., Кутузов В., Лучинин В., Попов В. Импортозамещение карбидокремниевой ЭКБ. Стратегическое партнерство СПбГГЭТУ «ЛЭТИ» и ПАО «Светлана»// Наноиндустрия. 2017. № 8 (79). С. 50-59.</p> <p>11. Ivanov, O.A., Bogdanov, S.A., Vikharev, A.L., Luchinin, V.V., Golubkov, V.A., Ivanov, A.S., Ilyin, V.A. Emission properties of undoped and boron-doped nanocrystalline diamond films coated silicon carbide field emitter array. Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics Volume 36, Issue 2, 1 March 2018, Номер статьи 021204 https://doi.org/10.1116/1.5012977</p> <p>12. V.A. Ilyin1, , A.V. Afanasyev, Yu.S. Demin, B.V. Ivanov, A.F. Kardo-Sysoev, V.V. Luchinin, S.A. Reshanov, A. Schöner, K.A. Sergushichev and A.A. Smirnov 30 kV Pulse Diode Stack Based on 4H-SiC. Materials Science Forum Submitted: 2017-09-08 ISSN: 1662-9752, Vol. 924, pp 841-844 Accepted: 2017-11-04 doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.924.841 Online: 2018-06-05 © 2018 Trans Tech Publications, Switzerland</p> <p>13. Lagosh A.V., Golubkov V.A., Ilyin V.A., Korlyakov A.V., Luchinin V.V. Silicon Carbide Micromechanical and Autoemission Structure-Based RF Switches for Harsh Environments. 2018 IEEE International Symposium on Radio-Frequency Integration Technology, RFIT 2018. 5 November 2018, Номер статьи 8524078</p>
--	---

		14.А.В.Афанасьев, В.А.Ильин, В.В.Лучинин. А.И. Михайлов. Газофазная эпитаксия – ключевая технология силовых транзисторов на карбиде кремния. Наноиндустрия, т.11, №7- 8(86), с.с.488-497, 2018,DOI: 10.22184/1993- 8578.11.7-8.488.497
--	--	---

Директор департамента науки



В. В. Лучинин